

校友陈星弼院士当选IEEE Fellow

发布时间: 2019-01-23 浏览次数: 1059



日前, 国际电气与电子工程师协会 (IEEE, The Institute of Electrical and Electronics Engineers) 2019年度IEEE Fellow (会士) 名单揭晓, 陈星弼院士因对功率超结金属氧化物半导体场效应晶体管的突出贡献当选2019年度IEEE Fellow。

陈星弼是中国科学院院士, 国际著名微电子学家, 被誉为“中国功率器件领路人”。1952年大学毕业后, 分配到厦门大学电机系当助教, 后先后转到南京工学院无线电系、成都电讯工程学院 (现电子科技大学)。他是我国第一批学习及从事半导体科技的人员之一, 是原电子部“半导体器件与微电子学”专业第一个博士生导师且获得第一个博士点。他从1981年起开始对功率半导体器件进行研究, 第一个提出了各种终端技术的物理解释及解析理论。他提出了两类纵向导电的器件新耐压结构, 并作了唯一的三维电场分析结果, 被国际学术界誉为功率器件的新里程碑。他发表超过170篇论文和40余项中美发明专利, 其中著名的超结发明被国际专利他引超过550次; 发表著作逾10部, 主持完成多项国家重点项目并屡次获得国家奖。因对高压功率MOSFET理论与设计的卓越贡献, 陈院士于2015年5月获得IEEE ISPSD大会颁发的最高荣誉“国际功率半导体先驱奖”, 是亚太地区首位获此殊荣的科学家。2018年5月, 因发明的超结器件而入选IEEE ISPSD首届全球名人堂 (全球共32位, 国内首位)。

IEEE是目前世界上电气与电子工程技术研究领域中最著名、规模最大的跨国学术组织。IEEE Fellow 为IEEE最高等级会员, 是IEEE 授予成员的最高荣誉, 在学术科技界被认定为权

威的荣誉和重要的职业成就。当选人需要对工程科学与技术的进步或应用做出重大贡献, 为社会带来重大价值。当选人数不超过IEEE 当年会员总数的0.1%。

(文\宣传部 陈浪 图\校友总会秘书处)

责任编辑: 黄伟彬